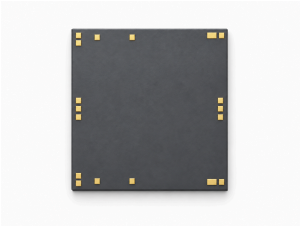
Die amplificador de potência GaN MMIC de 10000–13000 MHz

LCI-PA-10000-13000-PS45T é um amplificador de potência GaN MMIC em die sem encapsulamento para 10000–13000 MHz. Permite operação em CW e pulsada.



Valores da tabela RF: Potência de saída saturada: 45 dBm (típico); Ganho de potência: 20 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 40 % (típico). Condições de teste RF: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V. Dimensões do die: 3.3 × 3.5 × 0.1 mm.

Características RF

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Frequência de operação	f	10000	-	13000	MHz
Potência de saída saturada	Psat	-	45	-	dBm
Ganho de potência	Gp	-	20	-	dB
Planicidade do ganho de potência	ΔGp	-	±0.3	-	dB
Eficiência de potência adicionada	PAE	-	40	-	%

Polarização DC e correntes

TA = +25 °C

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Tensão de dreno	Vd	24	28	30	V
Tensão de porta	Vg	-3.1	-2.6	-2.4	V
Corrente de dreno em repouso	Id	-	0.7	-	A
Corrente dinâmica de dreno	Idd	-	3.3	-	A
Corrente dinâmica de porta	Igg	-	-	2	mA

Valores limite

Valores limite; não são pontos de operação normal.

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Valor	Unidade
Tensão dreno-fonte máxima	Vd	-	-	30	-	V
Polarização mínima da porta	Vg	-5	-	-	-	V
Potência de entrada máxima	Pin	-	-	28	-	dBm
Temperatura máxima do canal	Top	-	-	225	-	°C

Valores limite

Valores limite; não são pontos de operação normal.

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Valor	Unidade
Temperatura de armazenamento	TSTG	-65	-	150	-	°C
Tolerância a descasamento de carga	-	-	-	-	3:1	-

Dimensões do die

Parâmetro	Valor	Unidade
Dimensões do die	3.3 × 3.5 × 0.1	mm
Tolerância do contorno em planta	±50 (Somente contorno em planta; a tolerância da espessura não está especificada.)	µm

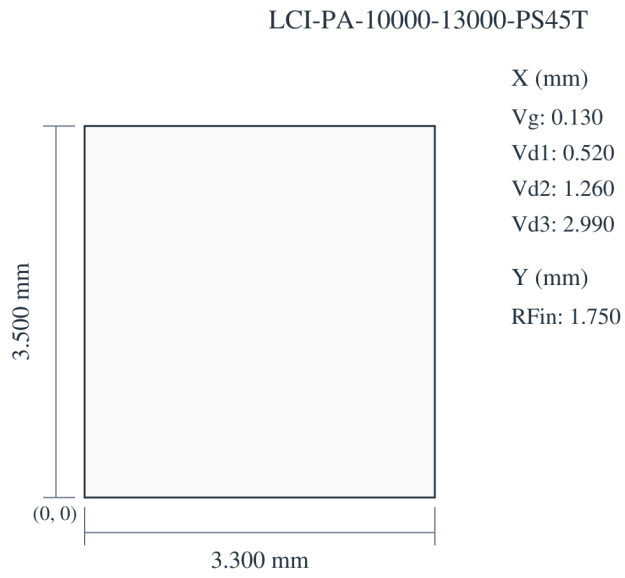
Registro da publicação atual · 1.6 · 2026-11-12. Atualização da descrição ou do conteúdo editorial. Substitui a revisão 1.5.

Integração do die e sequência de polarização

Ao ligar, aplicar a polarização de porta antes da de dreno. Ao desligar, remover primeiro a polarização de dreno. Manusear em ambiente limpo com proteção ESD e usar um suporte com expansão térmica compatível com o die de SiC.

Desenho dimensional mecânico

Contorno e coordenadas cotadas em mm. Este desenho serve como referência dimensional. A fabricação e a interconexão por fios exigem desenhos completos.



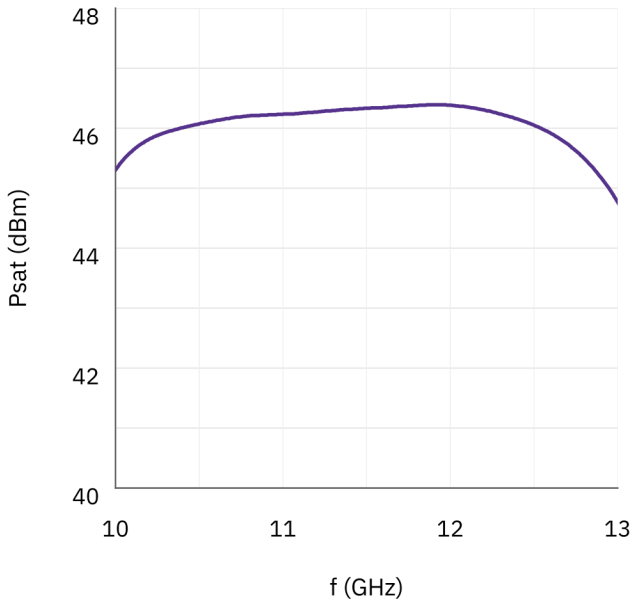
3.300 × 3.500 × 0.100 mm
X, Y: ±0.050 mm
X → · Y ↑ · X, Y: mm

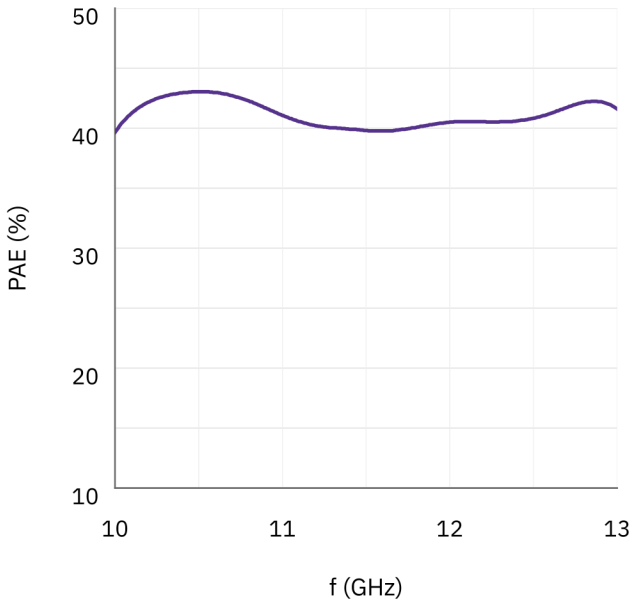
Curvas de desempenho

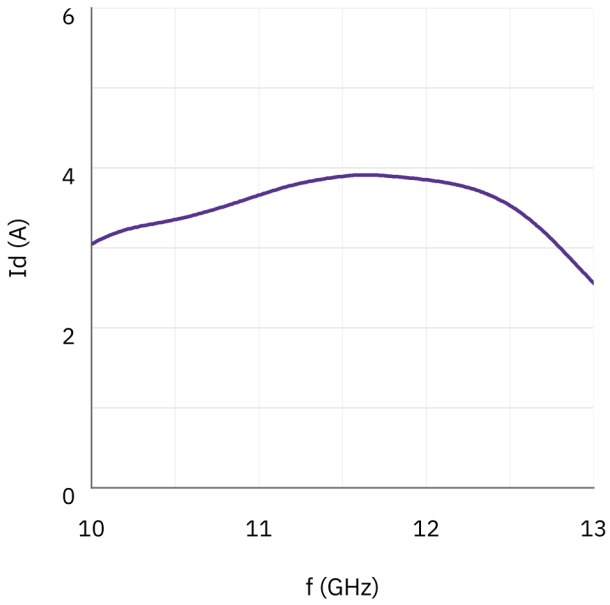
Cada gráfico de desempenho corresponde às condições de operação indicadas na figura.

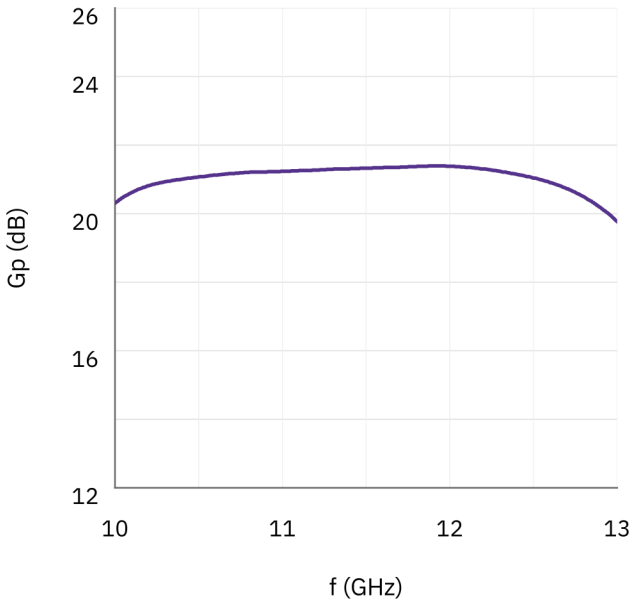
Pulsado — Potência de saída saturada; Eficiência de potência adicionada; Corrente dinâmica de dreno; Ganho de potência.

Notas da figura: Vd=+28V; Vg=-2.6V. Pin = 25 dBm. Largura de pulso = 100 µs; ciclo de trabalho = 10%. As leituras são aproximadas.



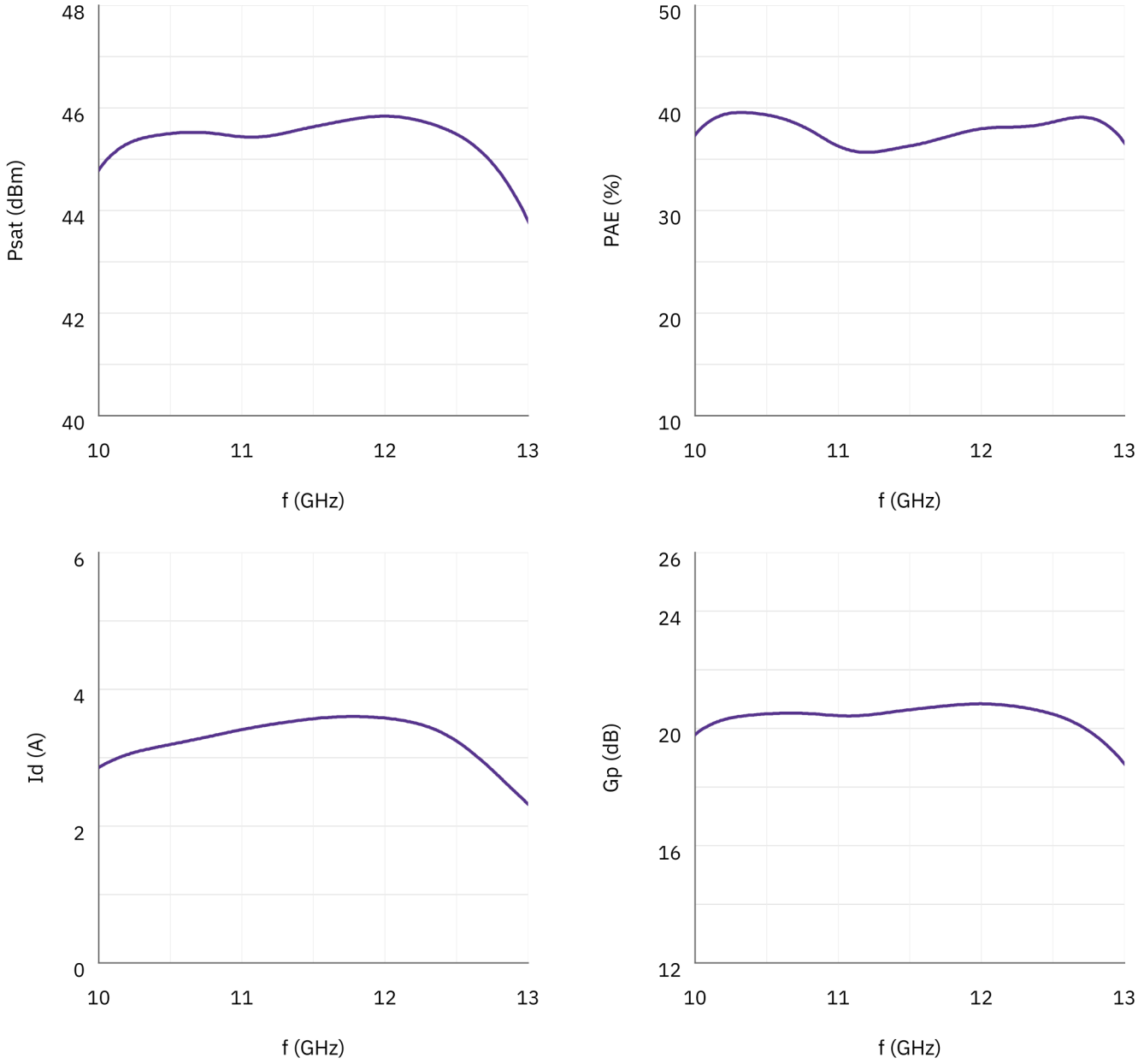






Onda contínua (CW) — Potência de saída saturada; Eficiência de potência adicionada; Corrente dinâmica de dreno; Ganho de potência.

Notas da figura: Vd=+28V; Vg=-2.6V. Pin = 25 dBm. As leituras são aproximadas.



Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.